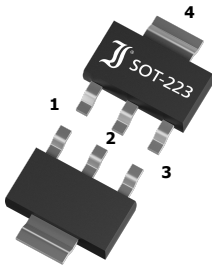


BCP53
SMD General Purpose PNP Transistors
SMD Universal-PNP-Transistoren

$I_C = -1\text{ A}$
 $h_{FE} > 40/63/100$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = -80\text{ V}$
 $P_{tot} = 2\text{ W}$

Version 2021-08-27

SOT-223SPICE Model **STEP** File ¹⁾

Marking Code
 Type / Typ

HS Code 85412100**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

High collector current
 Low saturation voltage
 Three current gain groups
 Compliant to RoHS (exemp. w/o),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions



2500 / 13"
 0.04 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Hoher Kollektorstrom
 Niedrige Sättigungsspannung
 Drei Stromverstärkungsklassen
 Konform zu RoHS (keine Ausn.),
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Type Typ	Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BCP53	BCP56

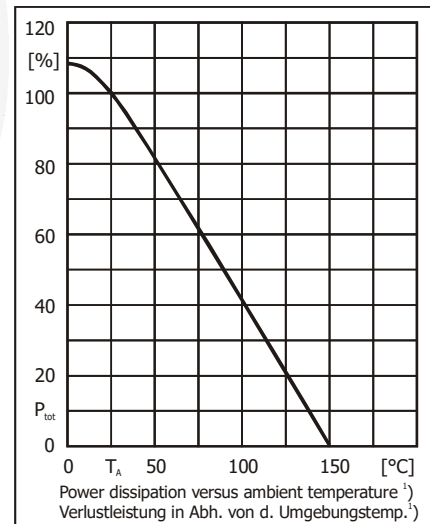
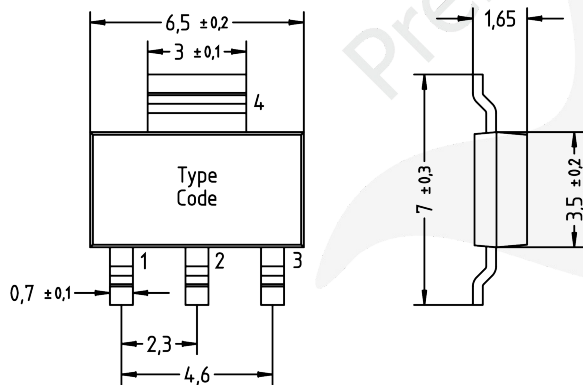
Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			BCP53/-Q
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CE0}	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V_{CBO}	100 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V
Power dissipation Verlustleistung	$T_s = 120^\circ\text{C}$	P_{tot}	2 W ³⁾ 1.3 W ⁴⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I_C	1 A
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	1.5 A
Base current – Basisstrom	DC	- I_B	100 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- I_{BM}	200 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+150°C

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- Measured at collector terminal 4 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 4
- Mounted on P.C. board with 600 mm² copper pad at the collector terminal
Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Kupferbelag (Löt-pad) am Kollektor-Anschluss

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 5\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	25	–	–
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 150\text{ mA}$	Group -6	h_{FE}	40	–	100
	Group -10	h_{FE}	63	–	160
	Group -16	h_{FE}	100	–	250
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	25	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾					
- $I_C = 500\text{ mA}$, - $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{CEsat}	–	–	0.5 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾					
- $I_C = 500\text{ mA}$, - $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{BE}	–	–	1 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 30\text{ V}$, (E open)		- I_{CBO}	–	–	100 nA
- $V_{CB} = 30\text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$, (E open)		- I_{CBO}	–	–	10 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
- $V_{EB} = 5\text{ V}$, (C open)		- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	120 MHz	–
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	93 K/W ²⁾		
Typical thermal resistance junction to soldering point Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Lötverbindung		R_{thS}	27 K/W ³⁾		

Dimensions - Maße [mm]


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 600 mm² copper pad at the collector terminal
Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Kupferbelag (Lötpad) am Kollektor-Anschluss
- 3 Measured at collector terminal 4 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 4

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)
[NTE26](#)